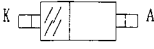
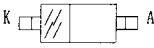
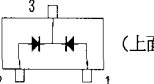
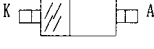
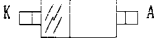
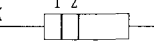
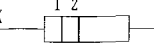
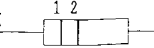


一般項目	最大定格		電気的 特性				備考	ピン接続図	
	項目	定格値	項目	最小	標準	最大			測定条件
●1SS318 □ーム 用途:高周波スイッチング用 特長:超小型(DSM),高信頼度。	V_R (V)	35	V_F (V)		0.84	1.00	$I_F=10mA$	バンドスイッチングダイオード	
	I_F (mA)	100	I_R (nA)		0.50	10.00	$V_R=25V$		
	T_j (°C)	125	Ct(pF)		0.94	1.20	$V_R=6V, f=1MHz$		
			r_F (Ω)		0.70	0.90	$I_F=2mA, f=100MHz$		
●1SS356 □ーム 用途:高周波スイッチング用。 特長:面実装タイプ(USM)。高信頼度。	V_R (V)	35	V_F (V)			1.00	$I_F=10mA$	バンドスイッチングダイオード	
	I_F (mA)	100	I_R (nA)			10.00	$V_R=25V$		
	T_j (°C)	125	Ct(pF)			1.20	$V_R=6V, f=1MHz$		
			r_F (Ω)			0.90	$I_F=2mA, f=100MHz$		
●1SS364 東芝 用途:VHF チューナ バンドスイッチ用 特長:容量が小さい。順抵抗が小さい。	V_R (V)	30	I_R (μA)			0.10	$V_R=15V$	マーキング:BF	
	I_F (mA)	50	V_F (V)			0.85	$I_F=2mA$		
	T_j (°C)	125	Ct(pF)		0.85	1.20	$V_R=6V, f=1MHz$		
			r_S (Ω)		0.60	0.90	$I_F=2mA, f=100MHz$		
●1SS371 東芝 用途:VHF チューナのバンドスイッチ用 特長:総合静電容量が小さい。直列抵抗が小さい。	V_R (V)	30	V_F (V)			0.85	$I_F=2mA$	Ct:総合静電容量	
	I_F (mA)	100	I_R (μA)			0.10	$V_R=15V$		
	T_j (°C)	125	Ct(pF)		0.70	1.20	$V_R=6V, f=1MHz$		
			r_S (Ω)		0.50	0.90	$I_F=2mA, f=100MHz$		
●1SV28 日電 用途:VHF 帯減衰器,リミッタ,AGC用 特長:広帯域(UHF帯以上)。低駆動電流・広抵抗変化幅。小リブカス。	V_R (V)	100	V_F (V)		0.85	1.00	$I_F=50mA$	高周波抵抗 直列: r_{ds} 並列: r_{dp}	
	I_F (mA)	50	Ct(pF)		0.20	0.25	$V_R=6V, f=1MHz$		
	Pd(W)	1	r_{ds} (Ω)	1.60	2.50	3.60	$I_F=10mA, f=1.7GHz$		
	T_j (°C)	175	r_{dp} (Ω)	300.00	400.00	500.00	$I_F=10μA, f=1.7GHz$		
●1SV34 日電 用途:可変抵抗減衰器用 特長:10~1000MHzにおける電流制御の可変抵抗減衰器用	V_R (V)	100	V_F (V)		0.95	1.10	$I_F=50mA$	PIN ダイオード	
	V_{RRM} (V)	110	Ct(pF)		0.30	0.50	$V_R=50V, f=1MHz$		
	I_F (mA)	50	r_{ds} (Ω)	6.00	8.00	10.00	$f=100MHz, I_F=10mA$		
	P(mW)	250	r_{dp} (kΩ)	2.00	2.50		$f=100MHz, I_F=10μA$		
●1SV35 日電 用途:可変抵抗減衰器用 特長:10~1000MHzにおける電流制御の可変抵抗減衰器用	V_R (V)		V_F (V)				$I_F=50mA$		
	V_{RRM} (V)		Ct(pF)				$V_R=50V, f=1MHz$		
	I_F (mA)		r_{ds} (Ω)				$f=100MHz, I_F=10mA$		
	P(mW)		r_{dp} (kΩ)				$f=100MHz, I_F=10μA$		
●1SV80 日電 用途:可変抵抗減衰器用 特長:直流順バイアス電流により定まる直線性の良い可変抵抗として働く	V_R (V)	30	V_F (V)		0.95	1.10	$I_F=50mA$		
	I_F (mA)	50	Ct(pF)		0.40	0.50	$V_R=15V, f=1MHz$		
	P(mW)	250	r_{ds} (Ω)		10.00	15.00	$f=100MHz, I_F=10mA$		
	T_j (°C)	175	r_{dp} (kΩ)	1.00	5.00		$f=100MHz, I_F=10μA$		